

# OPERATION MEMOIRES : Moyens Humains

**9 permanents**  
**5 ATER**  
**14 doctorants**



Rachid  
BOUCHAKOUR  
(Pr)



Pascal  
MASSON  
(Pr)



Christophe  
MULLER  
(Pr)



Pierre  
CANET  
(MC)



Jean-Michel  
PORTAL  
(MC)

**Mémoires Innovantes Sur Silicium  
(MISSi)**

**Mémoires à  
Matériaux Avancés  
(MeMatA)**

**Analyses de Performances  
(AP)**

**Méthodes d'Analyse de  
Défaillances pour Circuits  
Logiques et Mémoires  
(MADCLM)**



Romain  
LAFFONT  
(MC)



Gilles  
MICAULO  
(MC)



Arnaud  
REGNIER  
(Doct)



Henia  
RAGAD  
(Doct)



Philippe  
FERRANDIS  
(MC)



Nicolas  
MENOUE  
(Doct)



Frédéric  
LALANDE  
(Pr)



Valery  
BOUQUET  
(Doct)



Samir  
BOUTAHAR  
(Doct)



Lionel  
FORLI  
(Doct)



Hassen  
AZIZA  
(ATER)



Rossella  
RANICA  
(Doct)



Romain  
WACQUEZ  
(Doct)



Fabien  
GILBERT  
(Doct)



Sétphanie  
JACOB  
(Doct)



Bertrand  
DELSUC  
(Doct)



Juliano  
RAZAFINDRAMORA  
(ATER)



Samir  
MOUHOUBI  
(Doct)



Bertrand  
SAILLET  
(Doct)



Manuel  
SELLIER  
(Doct)



Damien  
DELERUYELLE  
(ATER)



Laurent  
LOPEZ  
(ATER)



Sandrine  
BERNARDINI  
(ATER)



Olivier  
MERCIER  
(CDD)

L2MP, IMT, Technopole de Château Gombert  
13451 MARSEILLE Cedex  
Tél: 33 (0) 491 054 780, Fax: 33 (0) 491 054 782  
Email: rachid.bouchakour@polytech.univ-mrs.fr  
Internet: www.L2MP.fr

**Samir MOUHOUBI**

## Provenance

- Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Micro-électronique et Télécommunications)
- DEA de Physique et Modélisation des Systèmes Complexes, Université de Provence

## Titre de la thèse

**Modélisation de mémoires non-volatiles pour des applications hautes températures**

Directeur de Thèse Frédéric LALANDE

Co-encadrant Pierre CANET, Pascal MASSON

Financement MNRT

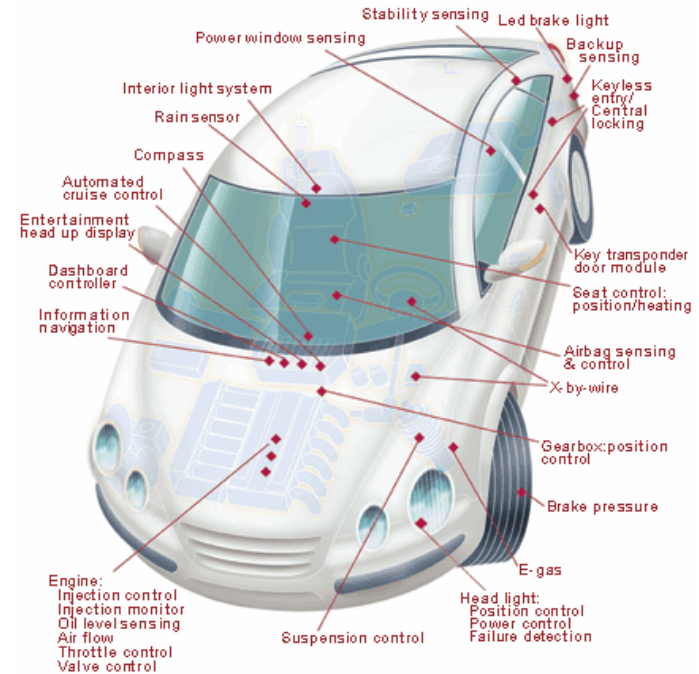
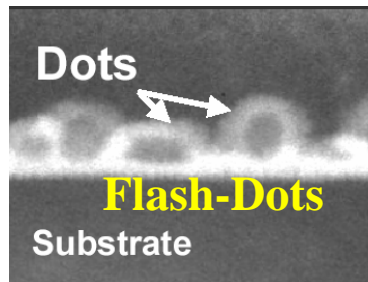
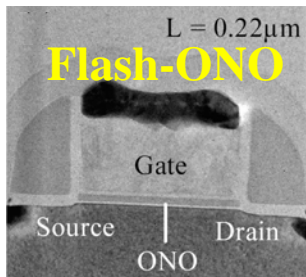
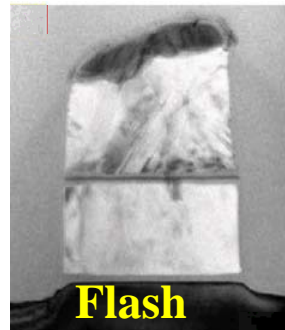
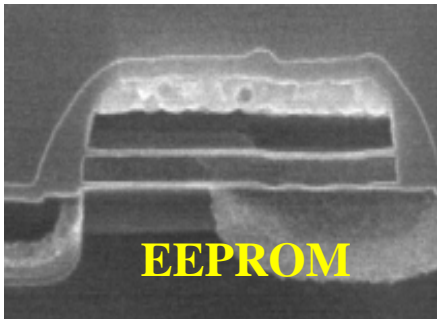
Collaboration AMI Semiconductor (Belgique)



**Samir MOUHOUBI**

## Modélisation des mémoires NVM

- Applications automobiles.
- Étude de l'effet de la température (cellules individuelles et matrices).
- Réalisation d'un modèle de courant de fuite en température.



## Choix de la technologie

- Choix du type de mémoire à embarquer en fonction des contraintes : température et fiabilité.